



# OPTO-ÉLECTRONIQUE

Travaux Pratiques

Semestre 5

---

## Caractériser un dipôle

---

Bloc 1



---

## Caractérisation d'un dipôle

---

À l'issue des séances de TP et de TD concernant le bloc 1, les étudiant·es seront capables de **caractériser un dipôle électronique** (linéaire ou non-linéaire) statiquement et en **déduire ses zones de fonctionnement**.

*Les sujets de TD ne sont pas inclus dans ce document.*

*Ce sujet est disponible au format électronique sur le site du LEnSE - <https://lense.institutoptique.fr/> dans la rubrique Année / Première Année / Opto-Electronique S5 / Bloc 1.*

---

Pour cela, ils·elles seront capables de :

- Lister les grandeurs et les paramètres d'intérêt du composant à partir d'une documentation technique fournie
  - Choisir les paramètres des instruments de mesures et des composants de protection
  - Tracer la caractéristique statique à l'aide :
    - d'un multimètre
    - d'un oscilloscope en mode XY
  - Décrire le fonctionnement d'un montage à diodes
- 

### Liste des missions

**Mission 1.1** Tracer la caractéristique  $i = f(u)$  d'une photodiode

**Mission 1.2** Mesurer le courant généré par une photodiode en mode capteur

**Mission 1.3** Tracer la caractéristique  $i = f(u)$  d'un dipôle de manière automatisée

**Mission 1.4** Tracer la caractéristique  $i = f(u)$  d'une LED

---

### Liste des autres ressources

- Caractériser un dipôle
- Doc : SFH206K (photodiode)
- Doc : LED rouge
- Fiche : Diode / LED / Photodiode
- Fiche : Photodétection

Un **feuillet annexe**, présentant succinctement l'**ensemble des instruments**, est disponible sur chacune des paillasses.



## Mission 1.1 / Tracer la caractéristique $i = f(u)$ d'une photodiode

Durée conseillée : 60 min / Séance 1

### Objectif de la mission

On se propose de **caractériser une photodiode**, c'est à dire de **tracer expérimentalement la loi mathématique** qui lie le courant traversant le dipôle et la différence de potentiel à ses bornes.

### Ressources

Vous pouvez utiliser les fiches résumées suivantes :

- **Fiche : Diode / LED / Photodiode**
- **Fiche : Photodétection**

### Photodiode SFH206K

On utilisera une photodiode de type **SFH206K** (une partie de la **documentation** est fournie en annexe).

→ **Q** Rechercher et relever dans la documentation technique du constructeur de la photodiode SFH206K les valeurs intéressantes pour la mise en œuvre pratique (électrique et optique) d'un tel composant.

### Méthode conventionnelle

Vous utiliserez une méthode classique de l'instrumentation pour relever les points de la courbe  $i = f(u)$ . Vous pourrez vous inspirer de la partie **Caractéristique manuelle** du tutoriel **Caractériser un dipôle**.

### Choix des appareils et des composants

Dans le schéma proposé dans le tutoriel **Caractéristique manuelle** du tutoriel **Caractériser un dipôle**, une résistance  $R_P$  est proposée comme protection en courant.

- **Q** Comment choisir cette résistance et comment régler les différents appareils de mesure ?
- **M** Relever la caractéristique  $i = f(u)$  de cette photodiode, lorsqu'elle est plongée dans l'obscurité, pour des tensions  $u$  positives ET négatives.

### Livrables

Une **fiche de manipulation** en ligne (partagée dans le cahier de laboratoire) rappelant :

- les protocoles de mesure et de réglage (schémas de mesure, de câblage)
- les tableaux de mesures et les courbes obtenues

Une **analyse** du résultat obtenu, en particulier sur les valeurs de courant obtenues pour une tension négative en présence ou non de photons.

---

## Mission 1.2 / Mesurer le courant généré par une photodiode en mode capteur

---

Durée conseillée : 30 min / Séance 1

### Objectif de la mission

On souhaite **mesurer le courant généré par une photodiode** (dans le domaine du visible) à l'aide d'un ampèremètre pour différentes valeurs d'éclairement.

### Ressources

Vous pouvez utiliser les fiches résumées suivantes :

- [Fiche : Diode / LED / Photodiode](#)
- [Fiche : Photodétection](#)

### Utilisation d'un luxmètre

Afin d'avoir une donnée de comparaison d'éclairement ambiant de la salle de travaux pratiques, un luxmètre est mis à votre disposition.

Vous pourrez ainsi comparer certaines données du constructeur avec vos résultats...

→ **M** A l'aide d'un luxmètre, relever des valeurs d'éclairement :

- dans l'obscurité,
- de la paillasse éclairée avec l'éclairage ambiant,
- de la paillasse éclairée avec une source supplémentaire (lampe de bureau ou lampe du téléphone portable).

→ **M** Relever les valeurs du courant  $i$  obtenu en sortie de la photodiode dans les trois conditions d'éclairage précédentes, pour une tension directe de l'ordre de 1 V et pour une tension inverse de 5 V (tension mesurée dans l'obscurité).

→ **Q** Dans quel cas est-il plus intéressant d'utiliser cette photodiode comme capteur de photons ?

### Livrables

Une **fiche de manipulation** en ligne (partagée dans le cahier de laboratoire) rappelant :

- les protocoles de mesure et de réglage (schémas de mesure, de câblage)
- les tableaux de mesures obtenues

Une **analyse** du résultat obtenu et une comparaison entre les valeurs expérimentale et théorique obtenues pour le courant en présence du flux lumineux ambiant.

---

**Mission 1.3** / Tracer la caractéristique  $i = f(u)$  d'un dipôle de manière automatisée

---

Durée conseillée : 60 min / Séance 2

## Objectif de la mission

On souhaite **caractériser une photodiode** (dans le domaine du visible), c'est à dire **tracer expérimentalement la loi mathématique** qui lie le courant traversant le dipôle et la différence de potentiel à ses bornes de manière plus automatisée que lors de la mission 1.1.

On souhaite voir également l'évolution de cette caractéristique en fonction de l'éclairement de la photodiode.

## Ressources

Vous pouvez utiliser les fiches résumées suivantes :

- [Fiche : Diode / LED / Photodiode](#)
- [Fiche : Photodétection](#)

## Méthode automatisée

Vous utiliserez cette fois-ci une méthode plus rapide pour relever une allure de la courbe  $i = f(u)$ . Vous pourrez vous inspirer de la partie **Caractéristique automatique** du tutoriel [Caractériser un dipôle](#).

- **M** Relever la caractéristique statique de la photodiode dans les deux cas suivants :
  - dans l'obscurité
  - en présence d'un flux lumineux (fourni par une source externe)
- **M** Mesurer, à l'aide d'un luxmètre, le flux lumineux émis par la source externe utilisée.

## Livrables

Une **fiche de manipulation** en ligne (partagée dans le cahier de laboratoire) rappelant :

- les protocoles de mesure et de réglage (schémas de mesure, de câblage)
- les tableaux de mesures et les courbes obtenues, copies d'écran d'oscilloscope en particulier

Une **analyse** du résultat obtenu et des zones d'utilisation possible d'une photodiode. On s'intéressera en particulier à la zone qui permet de mesurer un flux lumineux.

---

## Mission 1.4 / Tracer la caractéristique $i = f(u)$ d'une LED

---

Durée conseillée : 30 min / Séance 3 ou 4

### Objectif de la mission

On souhaite **caractériser une LED rouge**, c'est à dire **tracer expérimentalement la loi mathématique** qui lie le courant traversant le dipôle et la différence de potentiel à ses bornes, afin de déterminer un point de fonctionnement idéal pour transmettre un signal sinusoïdal.

### Ressources

Vous pouvez utiliser la fiche résumée suivante :

— **Fiche : Diode / LED / Photodiode**

### LED Rouge

On utilisera une LED rouge de type Kingbrighth L-1503ID (une partie de la **documentation** est fournie en annexe).

→ **Q** Rechercher et relever dans la documentation technique du constructeur de la LED les valeurs intéressantes pour la mise en oeuvre pratique (électrique et optique) d'un tel composant.

### Méthode automatisée

Vous utiliserez cette fois-ci une méthode plus rapide pour relever une allure de la courbe  $i = f(u)$ . Vous pourrez vous inspirer de la partie **Caractéristique automatique** du tutoriel **Caractériser un dipôle**.

→ **Q** Comment choisir la résistance de protection de la LED ? Comment régler les différents appareils de mesure pour éviter de dégrader la LED ?

→ **M** Relever la caractéristique statique de la LED.

### Livrables

Une **fiche de manipulation** en ligne (partagée dans le cahier de laboratoire) rappelant :

- les protocoles de mesure et de réglage (schémas de mesure, de câblage)
- les tableaux de mesures et les courbes obtenues

Une **analyse** du résultat obtenu.

Quelques lignes expliquant :

- dans quelle zone la LED peut-être utilisée pour moduler la lumière émise,
- les précautions à prendre pour obtenir une modulation sinusoïdale du flux lumineux.

## OPTO-ÉLECTRONIQUE

### Travaux Pratiques

Semestre 5

---

## Ressources

---

### Bloc 1

#### Liste des ressources

- **Caractériser un dipôle**
  - *Caractéristique Manuelle*
  - *Caractéristique Automatisée*
- **Doc : SFH206K (photodiode)**
- **Doc : LED rouge**
- **Fiche : Diode / LED / Photodiode**
- **Fiche : Photodétection**



## Caractéristique statique d'un dipôle

En électronique, la caractéristique statique d'un dipôle correspond à la relation mathématique  $i = f(u)$  qu'il existe entre la différence de potentiel  $u$  à ses bornes et le courant  $i$  le traversant, dans des conditions statiques, c'est-à-dire lorsque ces deux grandeurs ne sont pas dépendantes du temps.

Il existe deux méthodes principales pour caractériser statiquement un dipôle :

- **une méthode manuelle**, qui permet de tracer point à point cette courbe, en faisant varier  $u$  aux bornes du dipôle et en mesurant  $u$  et  $i$  pour un certain nombre de points,
- **une méthode automatique**, qui permet d'obtenir de manière plus rapide une allure de la caractéristique statique sur un oscilloscope.

### Caractéristique Manuelle

Une première méthode pour pouvoir **tracer la caractéristique statique**  $i = f(u)$  d'un dipôle est de faire varier la différence de potentiel à ses bornes de manière statique (i.e. très lente) et de mesurer la différence de potentiel  $u$  aux bornes du dipôle, à l'aide d'un voltmètre, et le courant  $i$  le traversant, à l'aide d'un ampèremètre, point par point.

Pour **faire varier la différence de potentiel** aux bornes du dipôle, on pourra prendre une **alimentation stabilisée réglable**.

Pour **mesurer la différence de potentiel** aux bornes du dipôle, on pourra utiliser un multimètre en mode **voltmètre** câblé en parallèle du dipôle.

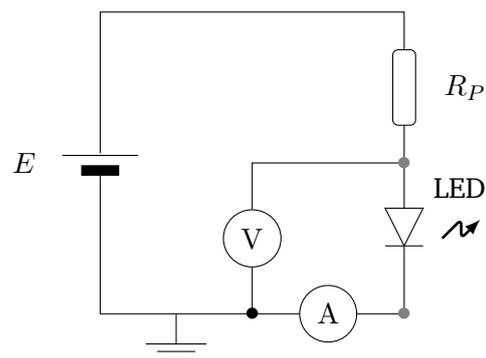
Pour **mesurer le courant** traversant le dipôle, on pourra utiliser un multimètre en mode **ampèremètre** câblé en série avec le dipôle.

### Circuit de mesure

On donne le schéma suivant pour mesurer à la fois le courant et la différence de potentiel aux bornes d'un dipôle (ici une diode).

### Méthode de mesure

On mesure à la fois le courant, à l'aide de l'ampèremètre branché en série, et la différence de potentiel aux bornes de la LED, à l'aide d'un voltmètre branché en parallèle.



On fait alors varier le potentiel de la source de tension  $E$ , pour relever, pour plusieurs points, les valeurs du courant (A) et de la différence de potentiel (V).

La plupart des multimètres permettent d'afficher simultanément la tension et le courant continu.

Les points peuvent ensuite être enregistrés dans un fichier de tableur (type Excel ou Calc). Cet outil logiciel permettra par la suite de tracer la courbe  $i = f(u)$ .

## Caractéristique Automatisée

Une seconde méthode permettant d'**obtenir une allure de la caractéristique statique**  $i = f(u)$  d'un dipôle est de faire varier la différence de potentiel à ses bornes en appliquant un signal dont l'amplitude varie lentement dans le temps. On peut alors mesurer la différence de potentiel  $u$  aux bornes du dipôle et le courant  $i$  le traversant à l'aide d'un oscilloscope en mode XY.

Cette méthode va nécessiter de **transformer le courant en différence de potentiel**, seule grandeur mesurable à l'aide d'un oscilloscope.

Pour faire **varier la différence de potentiel** aux bornes du dipôle, on utilisera une **générateur basse fréquence** (ou GBF).

Pour **mesurer la différence de potentiel** aux bornes du dipôle, on pourra utiliser une des voies de l'**oscilloscope** câblée en parallèle du dipôle.

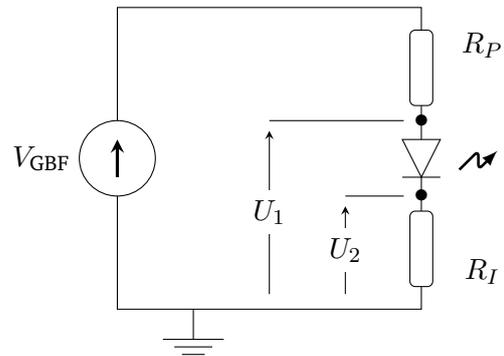
Pour **mesurer le courant** traversant le dipôle, on insérera une **résistance de faible valeur** (afin de ne pas perturber le reste du montage par l'ajout d'un système de mesure) en série avec le dipôle que l'on cherche à caractériser. On pourra alors utiliser la seconde voie de l'**oscilloscope** pour mesurer la différence de potentiel aux bornes de cette résistance. Par la loi d'Ohms, on retrouvera alors la valeur du courant.

### Circuit de mesure

On donne le circuit suivant pour tracer de manière automatisée l'allure de la caractéristique statique.

La résistance  $R_P$  est une résistance de protection du dipôle à caractériser (ici une LED).

La résistance  $R_I$  permet de convertir le courant traversant la branche en différence de potentiel mesurable par l'oscilloscope.



### Méthode de mesure

On applique un signal dont l'amplitude varie dans le temps à l'aide du GBF : un signal triangulaire par exemple à une fréquence de quelques Hertz. *On s'assurera que l'amplitude du signal fourni par le GBF est inférieure aux limitations des composants du montage.*

En mesurant à l'oscilloscope les tensions  $U_1$  sur une voie et  $U_2$  sur l'autre voie, on accède à une image de la tension aux bornes du dipôle ( $U_1 \sim U_2$ , assimilable à  $U_1$  si  $U_2$  est faible pour toutes les valeurs de  $i$ ) et à une image du courant traversant  $R_I$  ( $U_2$ ).

En traçant alors  $U_2$  en fonction de  $U_1$  (mode XY de l'oscilloscope), l'allure de la caractéristique statique du dipôle s'affiche alors.

## Maximum Ratings

 $T_A = 25\text{ °C}$ 

Parameter	Symbol		Values
Operating Temperature	$T_{op}$	min.	-40 °C
		max.	100 °C
Storage temperature	$T_{stg}$	min.	-40 °C
		max.	100 °C
Reverse voltage	$V_R$	max.	32 V
Total power dissipation	$P_{tot}$	max.	150 mW
ESD withstand voltage acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)	$V_{ESD}$	max.	2 kV

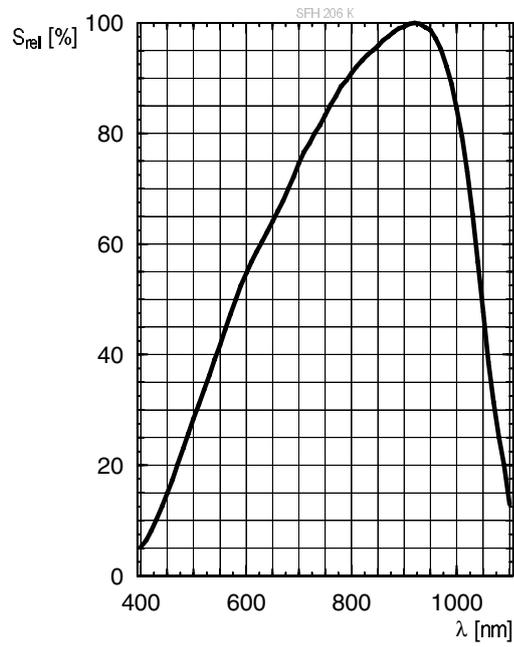
## Characteristics

$T_A = 25\text{ °C}$

Parameter	Symbol		Values
Spectral sensitivity $V_R = 5\text{ V}$ ; Std. Light A; $T = 2856\text{ K}$	S	min. typ.	50 nA/lx 80 nA/lx
Wavelength of max sensitivity	$\lambda_{S\text{ max}}$	typ.	920 nm
Spectral range of sensitivity	$\lambda_{10\%}$	typ.	420 ... 1120 nm
Radiant sensitive area	A	typ.	7.02 mm <sup>2</sup>
Dimensions of active chip area	L x W	typ.	2.65 x 2.65 mm x mm
Half angle	$\varphi$	typ.	60 °
Dark current $V_R = 10\text{ V}$	$I_R$	typ. max.	2 nA 30 nA
Spectral sensitivity of the chip $\lambda = 850\text{ nm}$	$S_\lambda$	typ.	0.62 A / W
Quantum yield of the chip $\lambda = 850\text{ nm}$	$\eta$	typ.	0.90 Electrons / Photon
Open-circuit voltage $E_v = 1000\text{ lx}$ ; Std. Light A; $V_R = 0\text{ V}$	$V_O$	min. typ.	310 mV 365 mV
Short-circuit current $E_v = 1000\text{ lx}$ ; Std. Light A; $V_R = 0\text{ V}$	$I_{sc}$	typ.	80 $\mu$ A
Rise time $V_R = 5\text{ V}$ ; $R_L = 50\ \Omega$ ; $\lambda = 850\text{ nm}$ ; $I_p = 800\ \mu$ A	$t_r$	typ.	0.02 $\mu$ s
Fall time $V_R = 5\text{ V}$ ; $R_L = 50\ \Omega$ ; $\lambda = 850\text{ nm}$ ; $I_p = 800\ \mu$ A	$t_f$	typ.	0.02 $\mu$ s
Forward voltage $I_F = 100\text{ mA}$ ; $E = 0$	$V_F$	typ.	1.3 V
Capacitance $V_R = 0\text{ V}$ ; $f = 1\text{ MHz}$ ; $E = 0$	$C_0$	typ.	72 pF
Temperature coefficient of voltage	$TC_V$	typ.	-2.6 mV / K
Temperature coefficient of short-circuit current Std. Light A	$TC_I$	typ.	0.18 % / K
Noise equivalent power $V_R = 10\text{ V}$ ; $\lambda = 850\text{ nm}$	NEP	typ.	0.041 pW / Hz <sup>1/2</sup>
Detection limit $V_R = 10\text{ V}$ ; $\lambda = 850\text{ nm}$	$D^*$	typ.	6.5e12 cm x Hz <sup>1/2</sup> / W

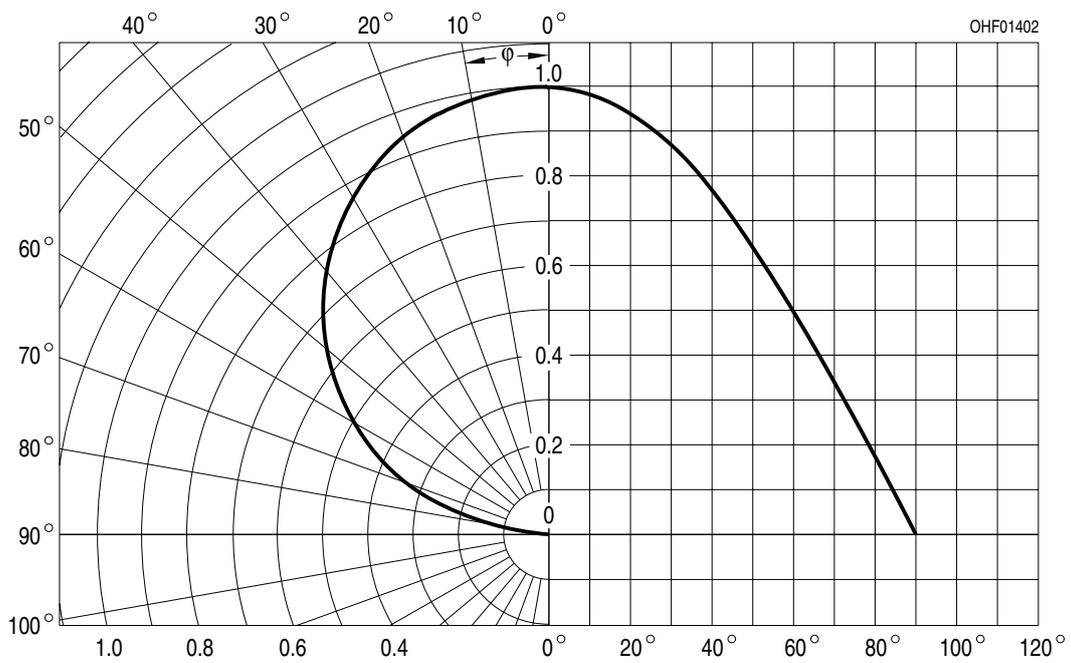
### Relative Spectral Sensitivity <sup>2), 3)</sup>

$$S_{rel} = f(\lambda)$$



### Directional Characteristics <sup>2), 3)</sup>

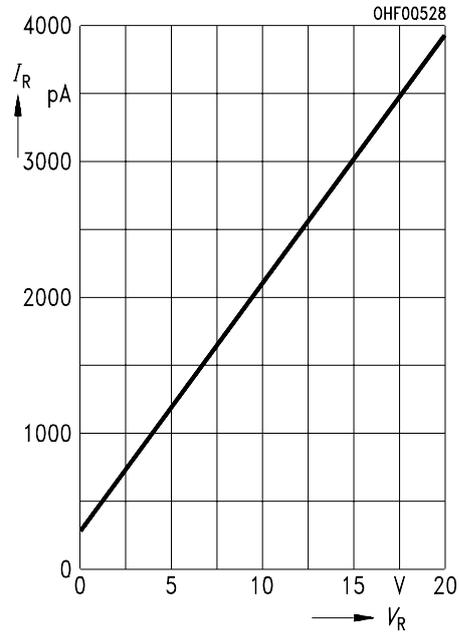
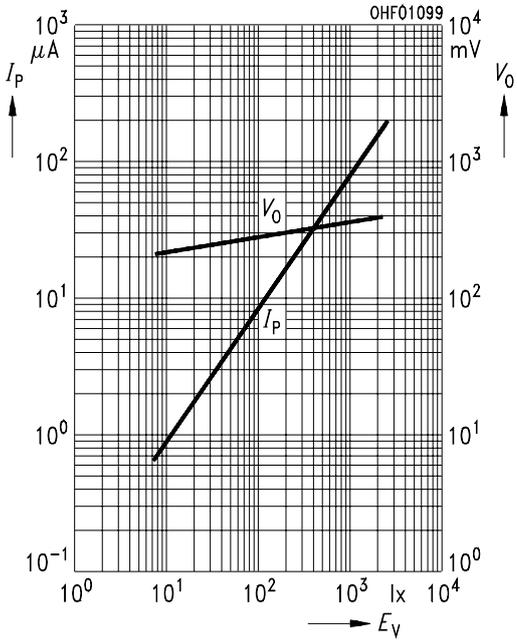
$$S_{rel} = f(\varphi)$$



**Photocurrent/Open-Circuit Voltage** <sup>2), 3)</sup> **Dark Current** <sup>2), 3)</sup>

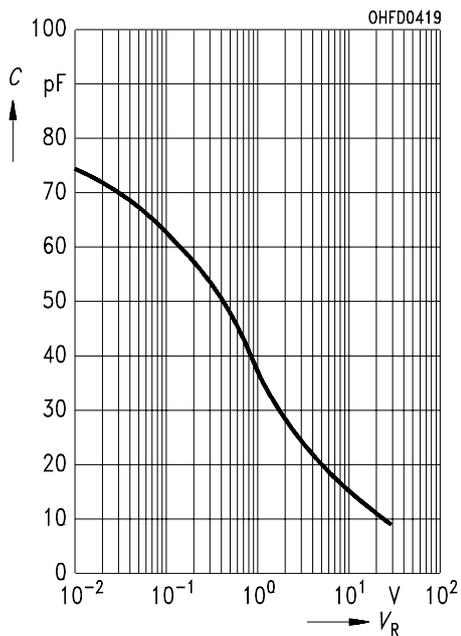
$I_P (V_R = 5 \text{ V}) / V_O = f(E_V)$

$I_R = f(V_R); E = 0$



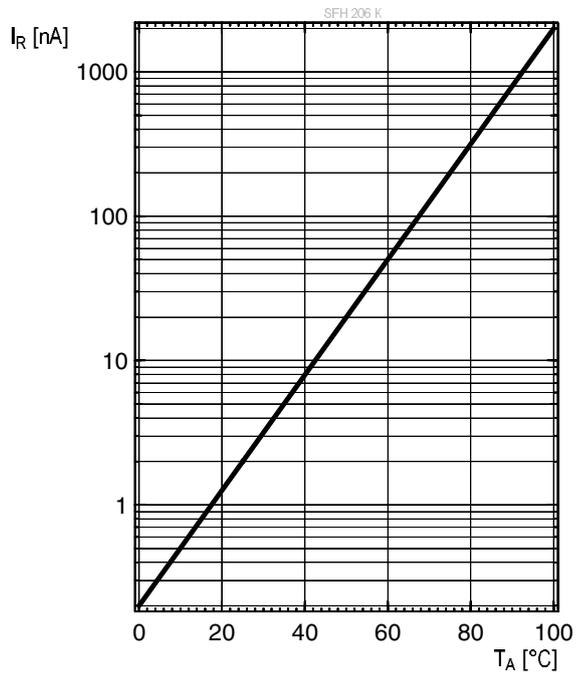
**Capacitance** <sup>2), 3)</sup>

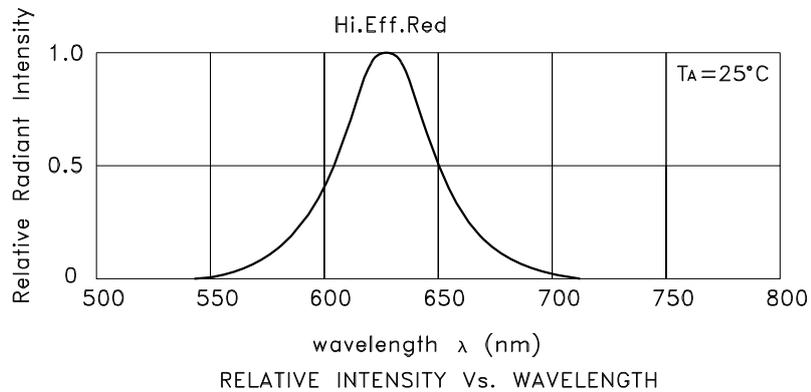
$C = f(V_R); f = 1\text{MHz}; E = 0; T_A = 25^\circ\text{C}$



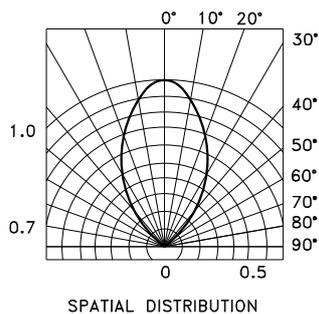
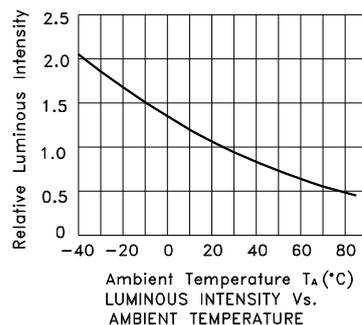
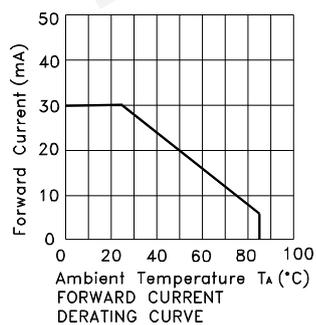
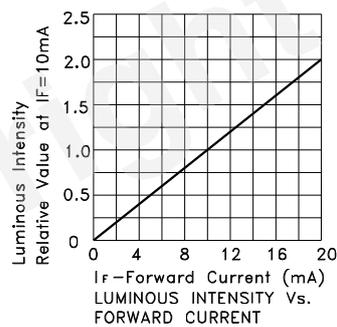
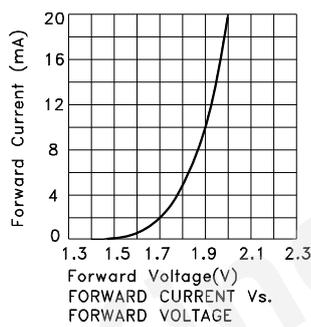
## Dark Current <sup>2)</sup>

$$I_R = f(T_A); E = 0; V_R = 10 \text{ V}$$





## High Efficiency Red L-1503ID



## Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] @ 10mA		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
L-1503ID	High Efficiency Red (GaAsP/GaP)	Red Diffused	25	50	60°
			*12	*40	

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.
- \* Luminous intensity value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

## Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ <sub>peak</sub>	Peak Wavelength	High Efficiency Red	627		nm	I <sub>F</sub> =20mA
λ <sub>D</sub> [1]	Dominant Wavelength	High Efficiency Red	617		nm	I <sub>F</sub> =20mA
Δλ <sub>1/2</sub>	Spectral Line Half-width	High Efficiency Red	45		nm	I <sub>F</sub> =20mA
C	Capacitance	High Efficiency Red	15		pF	V <sub>F</sub> =0V;f=1MHz
V <sub>F</sub> [2]	Forward Voltage	High Efficiency Red	2	2.5	V	I <sub>F</sub> =20mA
I <sub>R</sub>	Reverse Current	High Efficiency Red		10	uA	V <sub>R</sub> = 5V

Notes:

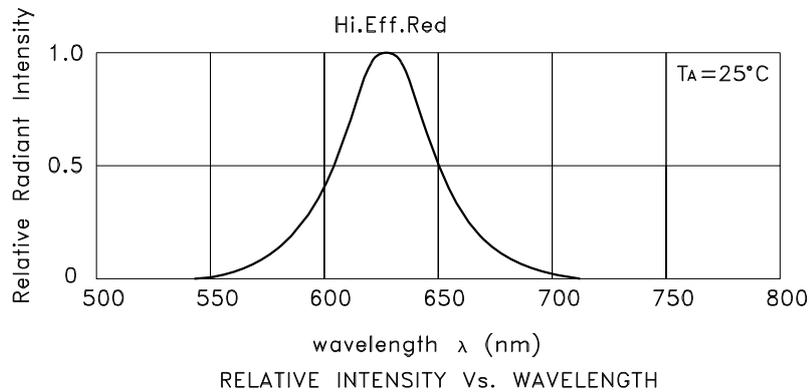
1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.
3. Wavelength value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

## Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

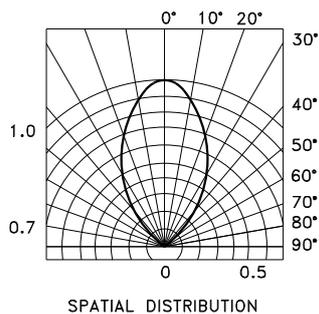
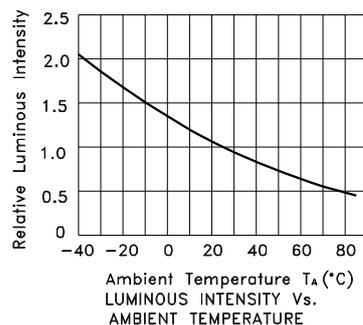
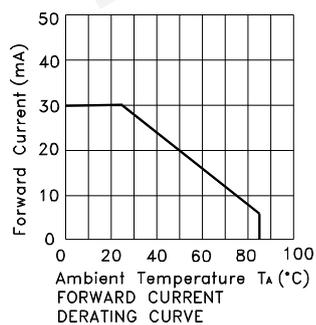
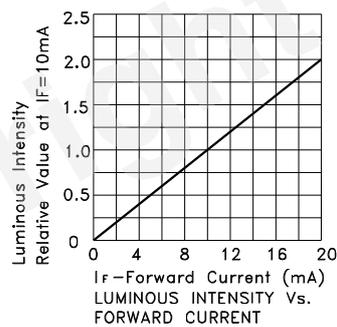
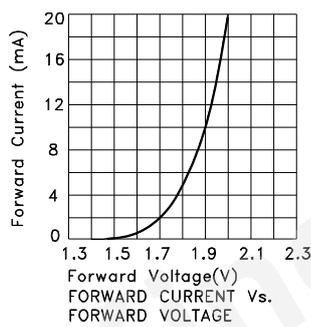
Parameter	High Efficiency Red	Units
Power dissipation	75	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	160	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating/Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 3 Seconds	
Lead Solder Temperature [3]	260°C For 5 Seconds	

Notes:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 2mm below package base.
3. 5mm below package base.



## High Efficiency Red L-1503ID



### DIODE

$I_F$  : **courant direct**  
souvent  $I_F < I_{FMAX}$

$V_F$  : **tension directe**  
aussi appelée seuil

$I_R$  : **courant inverse**

$V_R$  : **tension inverse**  
souvent  $V_R < V_{RMAX}$

### LED

LED : *Light-Emitting Diode*  
DEL : Diode électroluminescente

$\Phi_e$  : flux lumineux

### PHOTODIODE

$V_p$  : tension de polarisation  
 $I_{PhD}$  : courant proportionnel au flux lumineux

$$I_{photo} = S_{\lambda} \cdot \eta \cdot \Phi_{photo}$$

Sensibilité spectrale (A/W) → Flux lumineux (W)

Rendement quantique

### MODÈLE IDÉAL

Si  $u > 0$ , diode **passante**

Si  $u < 0$ , diode **bloquée**

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Si  $u > V_F$  diode **passante**  
émission de photons  
 $\Phi_e = k \cdot i$

$V_F$  dépendant de la longueur d'onde

**PARAMÈTRES IMPORTANTS :**

- $V_F$  ;  $I_{FMAX}$  ;  $V_{RMAX}$
- Bande-passante / temps de réponse
- $P_T$  : puissance totale dissipable
- Capacité (souvent parasite)

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

diode

cellule photovoltaïque

### MODÈLE SIMPLE

Si  $u > V_p$  diode **passante**

Si  $u < V_p$  diode **bloquée**

### CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

- $I_0$  : intensité lumineuse sur l'axe
- $\alpha$  : demi-angle (directivité)
- $\eta$  : rendement de conversion

$$\eta = \frac{\text{Nb photons émis}}{\text{Nb électrons}}$$

- $\lambda$  : longueur d'onde d'émission

<http://www.led-fr.net>

### MODÈLE COMPLET

Si  $u > 0$ , diode **passante**

$$i = I_0 [ \exp(u / n \cdot V_0) - 1 ]$$

loi exponentielle

$V_0$  : tension thermique  
 $V_0 = k \cdot T / e$

$T$  : température (K)  
 $k$  : Constante de Boltzmann  
 $e$  : charge d'un électron

$n$  : facteur de qualité

$I_0$  : constante spécifique à un type

$e = -1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$   
 $k = 1,38064852 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$

### EN PRATIQUE

R : résistance de protection en courant

$$R_{MIN} = \frac{V_{MAX} - V_F}{I_{FMAX}}$$

### EN PRATIQUE

**Montage simple**  $V_S = R_{PhD} \cdot I_{photo}$

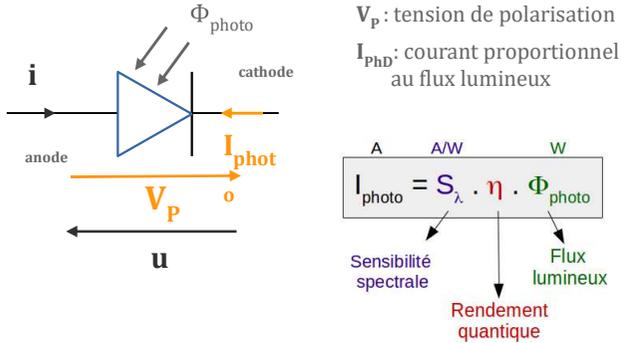
- Bande-passante limitée
- Capacité intrinsèque de la photodiode
- Sensible à l'impédance d'entrée du montage aval

**Montage transimpédance**  $V_S = R_{PhD} \cdot I_{photo}$

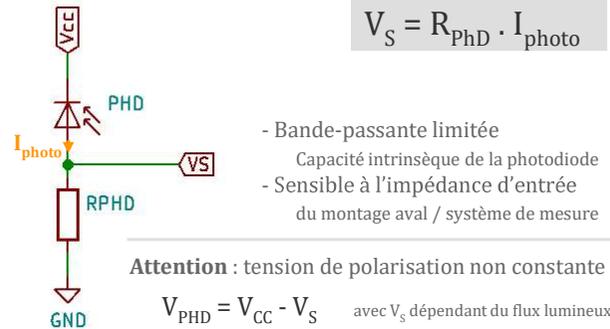
- + Bande-passante améliorée
- + Moins sensible à la capacité intrinsèque de la photodiode
- Apparition d'une résonance Gain-peaking / ALI

# Photodétection

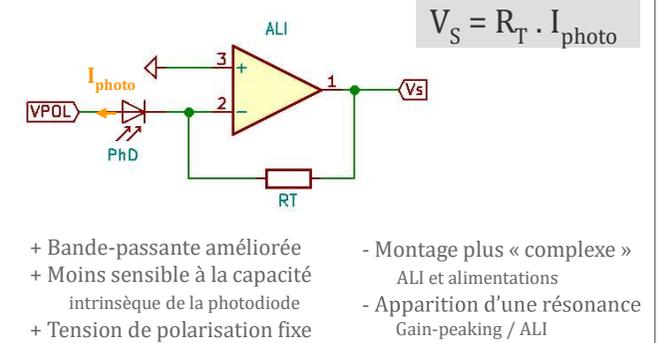
## PHOTODIODE = CAPTEUR



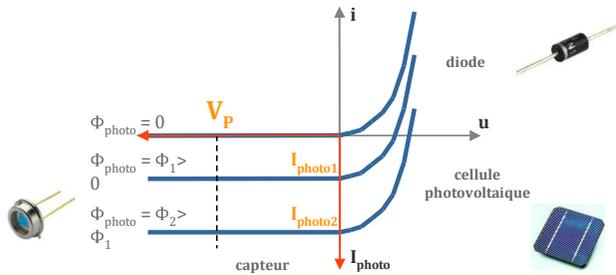
## MONTAGE « SIMPLE »



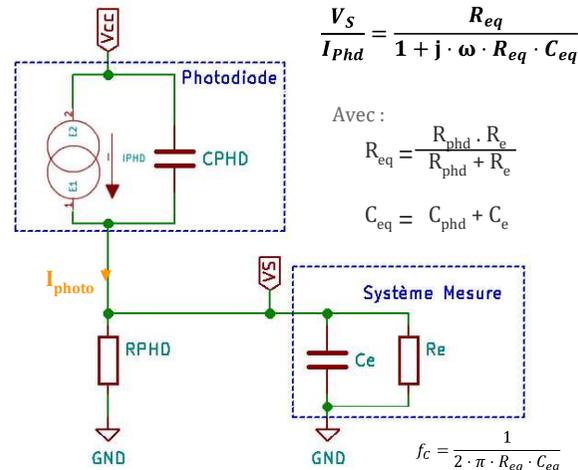
## MONTAGE TRANSIMPÉDANCE



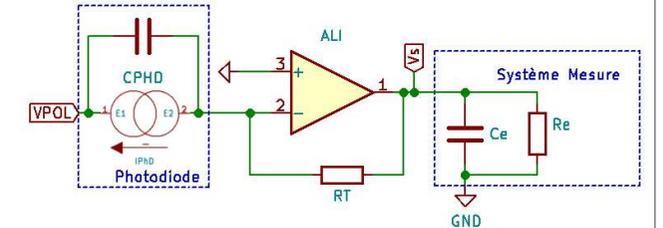
## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



## MODÈLE DU SYSTÈME DE MESURE



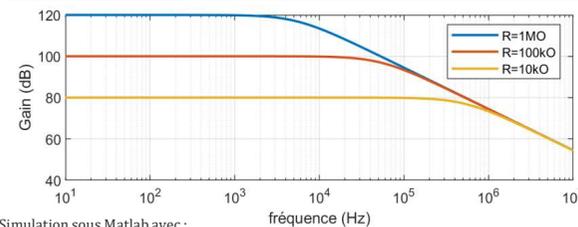
## MODÈLE DU SYSTÈME DE MESURE



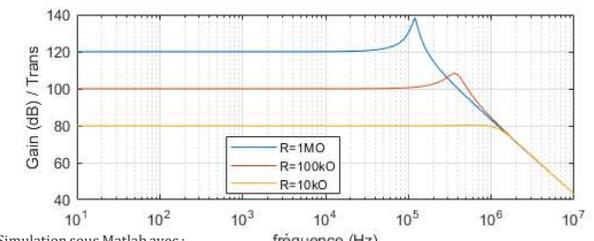
$$\frac{V_S}{I_{phD}} = \frac{R_T \cdot A_0}{\left(1 + \frac{j \cdot \omega}{\omega_0}\right) \cdot \left(1 + \frac{j \cdot \omega}{\omega_c}\right) + A_0}$$

En utilisant le modèle du premier ordre pour l'amplificateur intégré ( $A_0, \omega_0$ )

**Gain-peaking** :  $f_T = \sqrt{f_c \cdot GBP}$  avec  $f_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{phD} \cdot C_{phD}}$

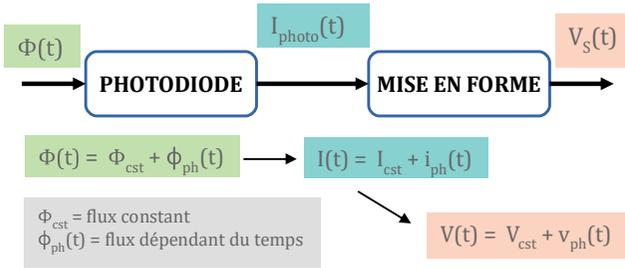


Simulation sous Matlab avec :  
 $R_e = 100M / C_{phd} = 70pF / C_e = 120pF$



Simulation sous Matlab avec :  
 $R_e = 100M / C_{phd} = 70pF / C_e = 120pF$

## SYSTÈME DE PHOTODÉTECTION



**Photodiode** : capteur permettant de mesurer un flux lumineux et de le convertir en courant

**Mise en forme** : étage de conversion d'une grandeur électrique vers une autre grandeur électrique plus facilement mesurable (amplification, filtrage...)